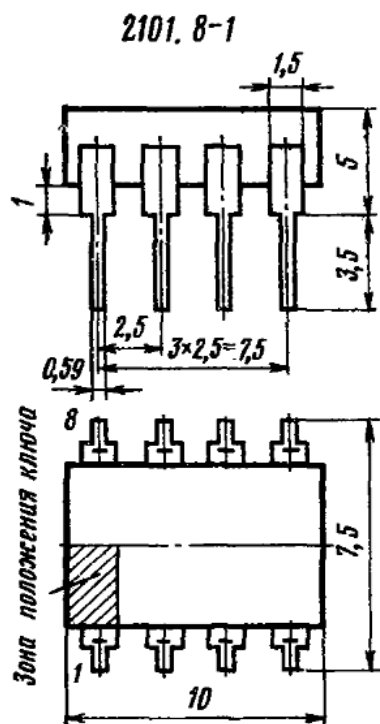
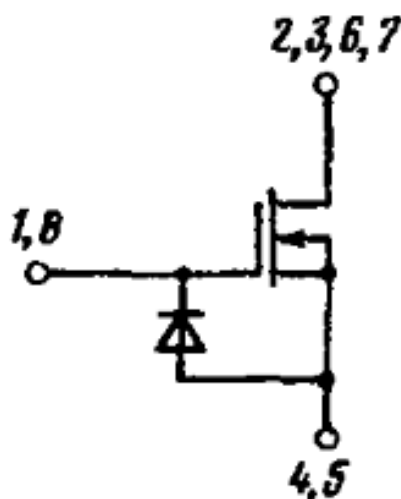


КР1014КТ1 (А, Б, В) — ключи на МОП-транзисторах



Габаритный чертеж корпуса
2101.8-1



Принципиальная схема микросхемы
КР1014КТ1

Описание

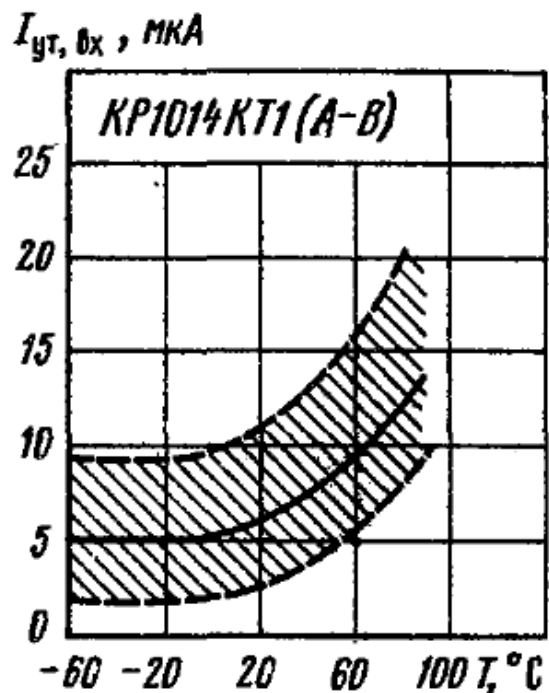
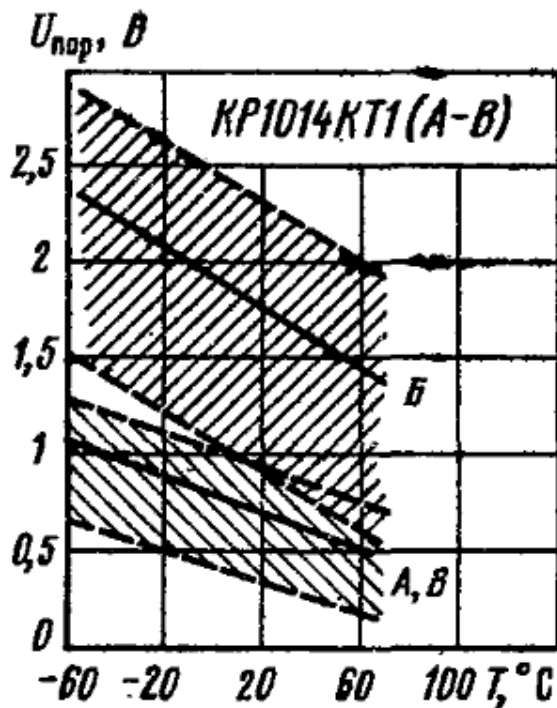
Микросхемы представляют собой ключи. Выполнены на МОП-транзисторах. Предназначены для коммутации электрических цепей. Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г.

Назначение выводов: 1, 8—управляющие входы; 4,

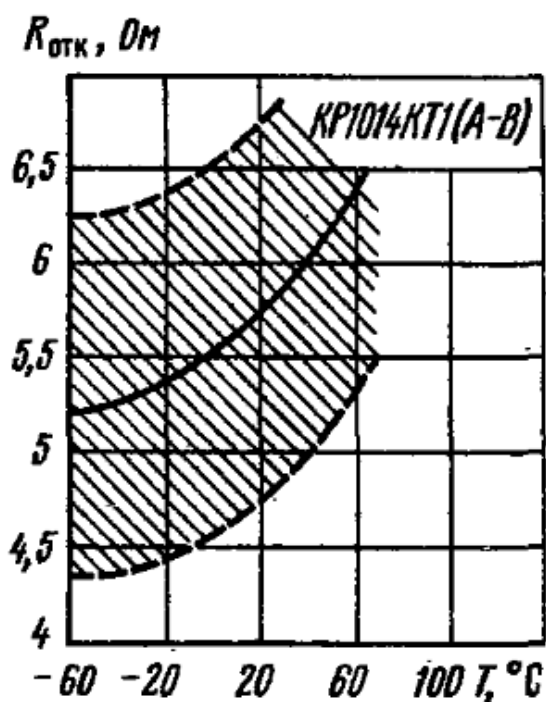
пайки не более 5 с.

Электрические параметры					
Параметры	Условия	KP1014KT1A	KP1014KT1B	KP1014KT1B	
Аналог	—	VN2410	VN2410	VN2410	
Обратное напряжение (падение напряжения на канале ключа при инверсном включении)	при $I_{\text{ком}} = 110$ мА, $T = +60...+70$ °С	не более 1	не более 1	не более 1	
Управляющий ток	$U_{\text{упр}} = 5$ В, $T = -60...+70$ °С	не более 1	не более 1	не более 1	
Ток утечки на входе	$U_{\text{ком}} = 75$ В, $T = -60...+55$ °С	не более 20	не более 20	не более 10	
Частота переключения	$U_{\text{упр}} = 5$ В, $U_{\text{ком}} = 75$ В, $t_{\text{фр,упр}} = 250$ нс, $R_{\text{вн,ист,с}} = 300$ Ом, $T = -60...+70$ °С	не более 100	не более 100	не более 100	
Время включения и выключения	$U_{\text{упр}} = 5$ В, $U_{\text{ком}} = 75$ В, $t_{\text{фр,упр}} = 250$ нс, $R_{\text{вн,ист,с}} = 300$ Ом, $T = -60...+70$ °С	не более 5	не более 5	не более 5	
	$I_{\text{ком}} = 35$ мА, $T = -60...+70$ °С, $U_{\text{упр}}$	не более 10	—	не более 10	

Предельно допустимые режимы эксплуатации					
Параметры	Условия	КР1014КТ1А	КР1014КТ1Б	КР1014КТ1В	Ед.изм
Управляющее напряжение	—	3,5	5,5	3,5	В
Напряжение затвор—сток в закрытом состоянии	—	75	75	75	В
	при $f = 50$ Гц, $Q = 2$, $t = 5$ мин	—	—	230	
Коммутируемый ток	—	110	110	110	мА
Рассеиваемая мощность	—	0,15	0,15	0,15	Вт
Температура окружающей среды	—	-60...+70	-60...+70	-60...+70	°С

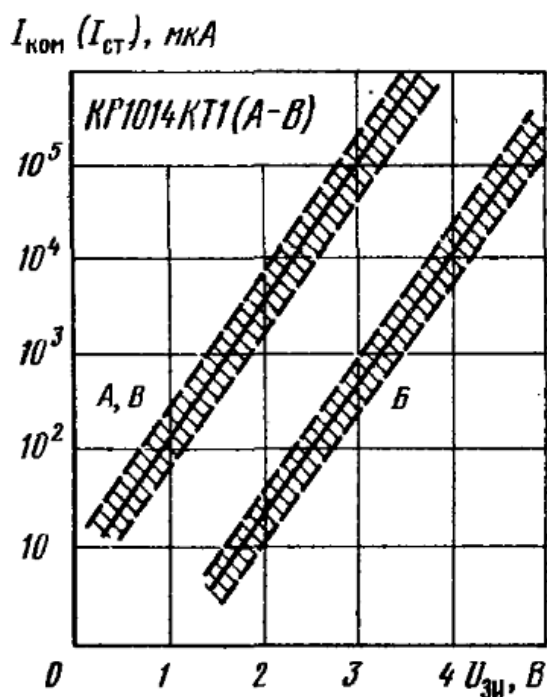


Зависимости порогового напряжения транзисторного ключа микросхемы от температуры окружающей среды. Заштрихованы области разброса параметра для 95% микросхем. Сплошными линиями показаны типовые зависимости

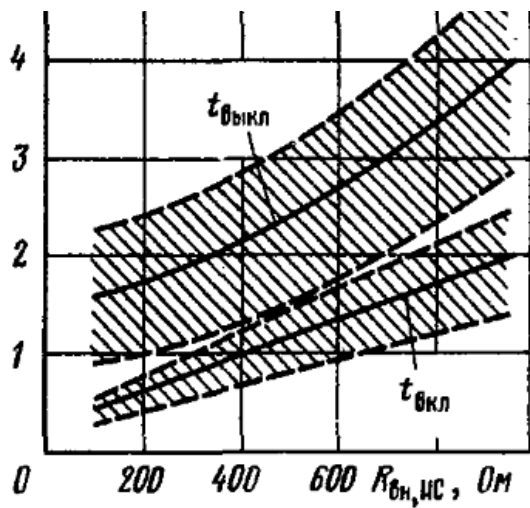


Зависимость сопротивления открытого ключа от температуры окружающей среды. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость

Зависимость входного тока утечки от температуры окружающей среды. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость



Зависимости коммутируемого тока микросхемами от напряжения затвор-исток. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость



Зависимости времени включения и выключения от вносимого сопротивления открытым ключом (сопротивления участка исток-сток). Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость